

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此乃概要，其並未載有對閣下而言可能屬重要的全部資料。閣下決定[編纂]前，務請閱讀本文件全文。

任何投資均涉及風險。[編纂]所涉及的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定[編纂]前應細閱該節。本概要所用眾多詞彙於本文件「釋義」及「技術詞彙」章節所界定。

概覽

我們是一家無晶圓廠功率半導體供應商，專門從事定製化功率器件產品的開發及供應。我們為客戶量身定製技術應用解決方案，提供定製的功率器件，用於安裝在終端用戶最終使用的電氣設備及電氣產品的電路板上，旨在實現特定性能或優化該等產品的功能。我們於往績記錄期間提供的產品主要是MOSFET，其次是IGBT、GaN MOSFET及SiC MOSFET，該等產品主要由我們的技術專家設計、定製及／或開發，專門按照客戶要求量身定製，用於其下游產品。通過開發定製解決方案，我們計劃發展及鞏固我們的行業地位，成為在細分領域為客戶提供高效及最佳解決方案的專家。

我們提供的產品用途廣泛，包括電源轉換器和電池管理系統。應用範圍涵蓋消費電子、工業控制、汽車電子、新能源及儲能、醫療設備等應用場景，廣泛用於掃地機器人、手持電動工具、無人機、各種消費電子適配器、LED照明、戶外儲能等應用產品。該廣泛適用性可增強我們的增長潛力，使我們能夠開拓多樣化的市場，適應不斷變化的行業趨勢。

功率半導體是一種用於電路中的電力轉換和電力控制的裝置。功率半導體通常具有兩種功能，即作為開關開啟或關閉電氣訊號，以及以較小電流或電壓控制較大電流的放大器。該等功能使功率半導體能夠自動和遠端開關電路，並將微弱的電信號放大為更大和更強大的電信號，以提高其所控制裝置的能效，並使需要較大電流的裝置能夠運作等等。功率半導體是器件半導體的重要元件，其性能會受到裝置中集成的晶體管數量的影響。

概 要

功率器件為功率半導體的子類，根據其結構和功能可分為幾種類型，即FET、IGBT及BJT。由於FET主要利用電壓控制、切換和放大電流，因此不會從電路的其他部分吸取電流，能更有效率地將盡可能多的電流留給其他電路功能。此外，MOSFET是FET的一個子類，是以快速切換速度和高效率著稱的電壓控制裝置，特別是在低電壓和高頻率的應用中。IGBT同樣利用電壓來控制、切換和放大電流，但能夠處理比MOSFET更高的電壓和電流，因此用於高功率應用。

MOSFET製造業為技術密集型行業，需要較高的整體專業技術水平。根據益普索的資料，隨著先進技術在下游產業的創新應用，MOSFET製造業的技術水平不斷進步，尤其是採用第三代半導體材料(如SiC與GaN)的MOSFET產品。與傳統的硅基材料相比，該等第三代材料具有更高的效率、更快的開關速度以及更高的熱穩定性。

由於MOSFET廣泛應用於消費電子產品、汽車應用和可再生能源系統，因此對其需求大幅增長，隨著更多行業因其在電源管理方面的優異性能而採用MOSFET，其用途預計將繼續擴大。中國MOSFET市場於2019年至2024年按複合年增長率12.2%增長，預計之後於2025年至2029年按複合年增長率5.0%擴大。

此外，芯片設計是MOSFET產業鏈中對研發能力要求較高的關鍵環節。根據益普索的資料，在下游需求快速增長的情況下，具有較強研發能力的國內公司可逐步追上國際主流MOSFET製造商，保持市場競爭力，進一步搶佔可觀的市場份額。

作為無晶圓廠供應商，我們的運營模式使我們能夠專注於產品設計及開發，同時將製造流程外包予專業代工廠及封裝廠。我們的主要目標是增強我們的產品設計能力並提升我們的產品技術水平。通過外包晶圓製造、封裝及測試，我們可專注於產品設計及開發方面的核心競爭力，確保交付優質產品，而不會產生與維護製造設施相關的開支。

我們的商業模式及產品

我們主要向客戶提供功率器件產品，專注於產品設計，同時外包製造與封裝流程予外部供應商。憑藉經驗豐富的研發部門，我們主要專注於設計及銷售符合國際公認標準的可靠性和穩定性的功率器件，尤其是MOSFET。憑藉我們的研發實力，我們提升了產品設計效率，且能夠為客戶提供優質產品。

概 要

我們的業務模式採用無晶圓廠方式運營，使我們能夠將資源集中於功率半導體產品的創新及設計，同時將製造及封裝外包予外部供應商。因半導體製造屬於資本密集行業，故無晶圓廠運營模式，不僅為我們減少資本支出，亦為我們提供快速適應不斷變化的市場需求及技術進步的靈活性。我們專注於設計及研發，使得我們可分配大量資源用於研發，推動我們產品供應的不斷創新。

半導體行業發展初期，半導體公司曾採用IDM模式經營並參與產品設計、製造、封裝及測試以及銷售全過程，該商業模式下，IDM可完全掌控生產流程，確保產品的高品質和可靠性，但其高昂的資本支出和較為僵化的結構可能會限制其對市場變化的應變能力。隨着行業不斷發展，開發人員的技能及分工日益專業化。由於無晶圓廠公司不需要大量的資本投資和支出，因此功率半導體設計公司以無晶圓廠的模式營運可能更具成本效益。此外，根據益普索的資料，由於功率半導體設計處於製造產業價值鏈的核心位置，與MOSFET製造產業價值鏈中的其他中游廠商相比，專門從事功率半導體(例如MOSFET)設計的公司，在過去三年中通常能獲得相對較高的平均毛利率。然而，彼等對代工廠的依賴會帶來供應鏈中斷和生產質量控制力下降的風險，並可能帶來知識產權風險。

我們重視直銷並與客戶保持密切關係。我們十分重視了解及滿足彼等對產品技術及性能可靠性的需求。該種以客戶為中心的方法推動我們的產品開發過程，使我們能夠量身定製產品來滿足特定的市場需求及挑戰。

我們設計和銷售的產品，主要為MOSFET。作為現代電子產品中的關鍵組件，我們的MOSFET在廣泛的應用中實現高效的電源管理及信號放大。我們對創新及質量的投入確保我們的產品能夠滿足包括消費電子、工業控制、汽車電子、新能源及儲能以及醫療設備在內的各個行業的嚴格要求。

概 要

我們的產品已應用於多種電子設備及下游產品。下表載列於往績記錄期間，按產品於客戶下游產品的應用情況劃分的產品銷售收益的明細：

下游產品應用	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	估收益的 收益	估收益的 百分比	估收益的 收益	估收益的 百分比	估收益的 收益	估收益的 百分比	估收益的 收益	估收益的 收益百分比	估收益的 收益	估收益的 百分比
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
消費電子	111,759	66.8	71,119	62.9	68,241	56.1	45,605	56.0	59,129	56.2
工業控制	35,205	21.0	33,976	30.0	40,916	33.6	27,705	34.0	31,790	30.2
汽車電子	16,862	10.1	2,999	2.7	3,873	3.2	2,240	2.7	6,797	6.5
新能源及儲能	3,447	2.1	4,955	4.4	8,619	7.1	5,908	7.3	7,449	7.1
醫療設備	36	0.0*	2	0.0*	7	0.0*	8	0.0*	-	0.0*
總計	<u>167,309</u>	<u>100</u>	<u>113,051</u>	<u>100</u>	<u>121,656</u>	<u>100</u>	<u>81,466</u>	<u>100.0</u>	<u>105,165</u>	<u>100.0</u>

附註*：本公司用於醫療設備之產品於2022財年、2023財年及2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月的佔比分別約為0.021%、0.001%、0.006%、0.01%及零。

競爭格局

我們在產品品質、滿足客戶期望的能力以及我們的經驗及聲譽方面面臨競爭。本行業的主要競爭因素一般包括產品穩定性及可靠性、價格競爭力、市場推廣及銷售能力以及品牌影響力。特別是中國的MOSFET製造行業高度集中，市場上有超過200家製造商。於2023年，按銷售額計算，前五大製造商約佔49.3%的市場份額，其業務均採用IDM模式。

我們的競爭優勢

我們相信，無晶圓廠模式降低了資本支出，使我們能夠採取以客戶為中心的策略。我們認為以下優勢有助於鞏固市場地位，確保成功並區別於競爭對手：(i)在定製化及以客戶為中心的銷售服務上的競爭優勢；(ii)多元且龐大客戶群；(iii)擁有開拓進取精神及豐富經驗的管理團隊；及(iv)廣泛的供應商網絡。

儘管市場上較新的IGBT、SiC MOSFET及GaN MOSFET產品的技術先進，我們相信該等發展將對本集團專注傳統硅基MOSFET產生的長期影響有限。雖然IGBT更適合具有更極端參數的高壓、重載及高功率應用，但傳統MOSFET於低、中、高壓位準上用途更廣泛，惟存在高溫下洩漏及電阻增加等性能問題。因此，MOSFET因其緊湊的尺寸及低功耗而更適合電源及消費電子產品。此外，與更簡單、更經濟的傳統MOSFET相比，IGBT、SiC MOSFET及GaN MOSFET的生產普遍更為複雜，成本更高。

概 要

雖然標準化產品能快速滿足通用需求(例如低成本、短週期)，但在滿足差異化場景下客戶的特定需求方面存在局限性，而由於應用場景的多元化，其無法在所有參數上實現最佳平衡，且可能無法滿足該等需求，而是需要通過結構化定製及場景適應以克服瓶頸。因此，定製化的MOSFET及其他功率器件產品為客戶提供性能優化，精確符合每個場景的特定需求(例如高頻、高電壓、高溫穩定性)。此外，其亦通過消除冗餘設計及增強關鍵參數(例如效率、可靠性、尺寸)的競爭力降低系統成本，從而在性能、成本及可靠性方面實現最佳解決方案。因此，我們的定製化服務及產品將不太可能輕易被標準化產品取代。

我們的發展策略

我們的業務發展戰略包括：(i)通過對設備、技術及人才的戰略投資來增強我們的研發能力；(ii)向海外市場進行戰略擴張；及(iii)拓寬客戶群並深化我們與客戶的關係。有關我們發展策略的詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」。

我們的客戶及供應商

我們的客戶主要包括MOSFET的下游直接客戶。於往績記錄期間各年度／期間，本公司五大客戶貢獻的收益分別佔2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月我們總收益的45.8%、31.7%、26.7%及29.4%。同期，我們向單一最大客戶的銷售額分別約為人民幣25.9百萬元、人民幣11.3百萬元、人民幣10.0百萬元及人民幣9.2百萬元，分別約佔我們收益的15.5%、10.0%、8.2%及8.7%。

我們的供應商主要包括從事晶圓銷售的公司、晶圓及功率器件製造與封裝公司，以及報關代理商。於往績記錄期間各年度／期間，我們向五大供應商的採購額分別佔2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月採購總額的73.8%、61.7%、55.0%及56.4%。同期，我們向單一最大供應商的採購額分別約為人民幣46.8百萬元、人民幣18.3百萬元、人民幣14.1百萬元及人民幣19.7百萬元，分別約佔我們總採購額的51.5%、35.1%、22.5%及28.6%。

雖然美國政府近年對從中國進口的商品徵收關稅及貿易限制，但該等貿易政策於往績記錄期間直至最後實際可行日期對我們的影響並不重大，是因為(a)我們的供應商(主要包括第三方晶圓代工廠及封裝廠)均不設於美國市場或從美國市場獲取原材料；及(b)我們幾乎所有的收益均來自在中國的銷售，且我們並無任何來自美國市場的直接客戶，亦不直接向美國客戶銷售產品。

概 要

據董事所知、所悉及所信，我們至少有一名客戶(即馬來西亞的客戶J)會向美國客戶銷售其自有電子產品。2022財年、2023財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月，我們向客戶J的銷售額分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣2.4百萬元，分別佔同期收益的2.7%、2.4%、3.7%及2.3%，可能涉及該等風險(「**已知風險敞口**」)。雖然我們的若干其他客戶可能已在美國或向美國客戶銷售各自的下游產品，鑒於我們無法獲得有關各自客戶的下游產品中銷往美國市場或美國客戶的的佔比資料，亦無法獲悉其針對美國市場的下游產品中使用本公司產品的比例，我們無法準確確定其銷售中受影響的部分。

風險因素

我們的業務及**[編纂]**涉及本文件「風險因素」所載的若干風險。閣下於決定**[編纂]**我們的**[編纂]**前應細閱整節。我們相信我們面臨的大多數主要風險包括但不限於如下：

- 在我們產品所出售的行業及市場中，於瞬息萬變的技術形勢下，我們的業務增長及前景取決於我們不斷創新及迭代的現有產品以及擴展產品組合及發展新技術的能力；
- 我們的業務在很大程度上取決於我們的銷售及營銷部門直接向客戶銷售我們的產品以及與客戶保持持續密切關係的能力；
- 我們分別與第三方晶圓代工廠及封裝廠合夥並依賴彼等製造及封裝功率半導體產品，這可能導致我們無法及時且以合理的成本獲得符合我們的規格及產品開發所需的材料和元件，或者遭遇製造服務中斷，這可能會對我們的收益及盈利能力造成不利影響。此外，我們對第三方晶圓代工廠及封裝廠的質量、供應能力及成本的控制或會有限，從而或會對我們的收益及盈利能力造成不利影響；
- 下游客戶對我們功率半導體產品的需求減少可能導致我們產品的售價下降，從而可能導致我們的收益、利潤率及盈利減少；及
- 由於功率半導體產品市場具有週期性，因此我們的過往表現可能無法反映我們未來的增長。如果我們無法有效管理增長或執行業務策略，我們的經營業績及業務前景可能會受到重大不利影響。此外，產量增加可能導致產能過剩和價格下降，反之，我們可能無法滿足對我們產品的意外需求，這可能會影響我們的營運業績。

有關進一步詳情，請參閱「風險因素」一節。

概 要

歷史財務資料概要

下表載列我們於所示年度的綜合損益及其他全面收益表概要：

	截至12月31日止年度			截至9月30日止九個月	
	2022年 人民幣千元	2023年 人民幣千元	2024年 人民幣千元	2024年 人民幣千元	2025年 人民幣千元
收益	167,309	113,051	121,656	81,466	105,165
銷售成本	<u>(74,023)</u>	<u>(50,904)</u>	<u>(52,444)</u>	<u>(35,242)</u>	<u>(45,084)</u>
毛利	93,286	62,147	69,212	46,224	60,081
其他收入及收益淨額	2,916	2,062	2,276	1,753	1,702
銷售及分銷開支	(14,360)	(13,427)	(15,540)	(10,061)	(12,350)
行政開支	(18,143)	(14,301)	(13,502)	(8,901)	(13,328)
金融資產減值撥回／(減值 虧損)，淨額	(156)	268	(220)	(92)	77
按公平值計入損益的金融資產的 公平值收益／(虧損)	2	402	(128)	84	(15)
其他開支	(79)	(13)	(49)	(76)	(213)
財務成本	<u>(1,305)</u>	<u>(1,221)</u>	<u>(963)</u>	<u>(808)</u>	<u>(273)</u>
除稅前溢利	62,161	35,917	41,086	28,123	35,681
所得稅開支	<u>(8,552)</u>	<u>(4,900)</u>	<u>(5,974)</u>	<u>(4,284)</u>	<u>(5,365)</u>
年度／期間溢利及年度／期間 全面收益總額	<u><u>53,609</u></u>	<u><u>31,017</u></u>	<u><u>35,112</u></u>	<u><u>23,839</u></u>	<u><u>30,316</u></u>
以下人士應佔：					
本公司擁有人	<u><u>53,609</u></u>	<u><u>31,017</u></u>	<u><u>35,112</u></u>	<u><u>23,839</u></u>	<u><u>30,316</u></u>

我們的收益由2023財年的約人民幣113.1百萬元增加約7.6%至2024財年的約人民幣121.7百萬元，主要是由於來自(i)溝槽MOSFET；(ii)超結MOSFET；及(iii)IGBT產品的收益增加。

概 要

我們的收益由2022財年約人民幣167.3百萬元減少約32.4%至2023財年約人民幣113.1百萬元，由於(i)SGT MOSFET及(ii)溝槽MOSFET產生的收益減少，惟部分被超結MOSFET產生的收益增加所抵銷。

我們的收益由截至2024年9月30日止九個月的約人民幣81.5百萬元增加約29.1%至截至2025年9月30日止九個月的約人民幣105.2百萬元，主要是由於(i)SGT MOSFET；及(ii)溝槽MOSFET產生的收入增加所致。

由於我們的收益、銷售成本及其他經營開支(主要為銷售及分銷開支、行政開支及研發開支)變動的整體影響，本公司擁有人應佔年度溢利較最近年度／期間增加。由2022財年至2023財年，溢利由約人民幣53.6百萬元減少約42.1%至約人民幣31.0百萬元，主要是由於(i)SGT MOSFET及(ii)溝槽MOSFET產生的收益減少，導致收益由2022財年的約人民幣167.3百萬元減少約32.4%至2023財年的約人民幣113.1百萬元，惟部分被超結MOSFET產生的收益增加所抵銷。然而，由2023財年至2024財年，溢利增加約13.2%至約人民幣35.1百萬元，主要是由於主要來自(i)溝槽MOSFET；(ii)超結MOSFET；及(iii)IGBT的收益由2023財年的約人民幣113.1百萬元增加約7.6%至2024財年的約人民幣121.7百萬元。此外，截至2024年9月30日止九個月與截至2025年9月30日止九個月比較，我們的溢利由約人民幣23.8百萬元增加約27.2%至約人民幣30.3百萬元，主要是由於收益由截至2024年9月30日止九個月的約人民幣81.5百萬元增加約29.1%至截至2025年9月30日止九個月的約人民幣105.2百萬元，主要為來自(i)SGT MOSFET；(ii)溝槽MOSFET；及(iii)超結MOSFET產生的收益增加。

我們於2022財年、2023財年及2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月分別售出約270.5百萬件、203.2百萬件、251.3百萬件、168.4百萬件及279.4百萬件產品，詳情如下：

產品類型		截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
產品種類	小類	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
		千件	%	千件	%	千件	%	千件	%	千件	%
MOSFET	溝槽	98,914	36.6	87,604	43.1	117,106	46.6	80,613	47.9	110,608	39.6
	SGT	168,790	62.4	111,321	54.8	128,798	51.3	84,369	50.0	162,698	58.2
	超結	1,945	0.7	3,736	1.8	4,990	2.0	3,168	1.9	5,507	2.0
IGBT		-	-	1	0.0*	103	0.0*	2	0.0*	53	0.0*
其他 ¹		877	0.3	539	0.3	333	0.1	279	0.2	531	0.2
總計		270,526	100	203,201	100	251,330	100	168,431	100.0	279,397	100.0

概 要

附註：

1. 其他包括SiC MOSFET、GaN MOSFET、晶圓及二極管。

* 我們銷售IGBT的數量分別約佔2023財年及2024財年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月銷售總量的0.001%、0.04%、0.001%及0.019%。

於2023財年，本集團的產品銷售總量約為203.2百萬件，較2022財年的約270.5百萬件減少約67.3百萬件或24.9%，主要是由於(i)SGT MOSFET的銷售減少約57.5百萬件；及(ii)溝槽MOSFET的銷售減少約11.3百萬件所致，這主要是由於中國功率半導體行業於2023財年的去庫存週期，乃因疫情導致全球晶片短缺及對半導體器件的需求增加，導致需求由2022財年大幅轉移至2023財年。然而，產能增加及疫情後經濟復甦緩慢導致供需失衡，令2023財年對功率半導體的需求下降，主要源於客戶採購產品組合從溝槽MOSFET轉向超結MOSFET。

於2024財年，本集團產品的總銷量約為251.3百萬件，較2023財年的約203.2百萬件增加約48.1百萬件或23.7%。該增長主要是由於我們客戶的業務活動普遍增加所致，這可從我們於不同應用場合(如工業控制、消費電子、新能源及儲能以及醫療設備)的產品採購量增加可見一斑。於2024財年，我們的IGBT產品銷售額亦錄得增長至約0.1百萬件，主要是由於售予中國新客戶約0.1百萬件所致。

截至2024年9月30日止九個月與截至2025年9月30日止九個月比較，總銷售量由約168.4百萬件增加至約279.4百萬件。於2025年首九個月，我們延續2024年財年的策略，利用現有客戶增加的業務活動，並繼續努力增加我們的客戶基礎。

於往績記錄期間，本公司產品的平均售價載列如下：

產品類別	產品類型 小類	截至12月31日止年度			截至 2025年 9月30日
		2022年 人民幣元	2023年 人民幣元	2024年 人民幣元	止九個月 人民幣元
MOSFET	溝槽	0.62	0.54	0.45	0.36
	SGT	0.60	0.54	0.46	0.36
	超結	2.56	1.71	1.73	1.32
IGBT		–	9.17	1.45	3.04
其他 ⁽¹⁾		0.13	0.15	0.27	0.10

附註1：其他包括SiC MOSFET、GaN MOSFET、晶圓及二極管。

概 要

於往績記錄期間，超結MOSFET及SGT MOSFET的平均售價呈下降趨勢。超結MOSFET的平均售價由2022財年的每件約人民幣0.62元降至截至2025年9月30日止九個月的每件約人民幣0.36元，而SGT MOSFET的平均售價由2022財年的每件約人民幣0.60元降至截至2025年9月30日止九個月的每件約人民幣0.36元。於2023財年，有關跌幅主要由於2022年年底產能增加及市場需求減弱導致原材料價格普遍下跌，從而導致存貨過剩。於2024財年，超結MOSFET及SGT MOSFET的平均售價繼續下降，主要是由於原材料價格進一步下調所致。截至2025年9月30日止九個月，平均售價下調是由於透過客戶協商策略性實施，以提升市場競爭力。

超結MOSFET的平均售價由2022財年的每件約人民幣2.56元降至2023財年的每件約人民幣1.71元，主要是由於原材料價格下降所致，原因如上文所述。於2024財年，平均售價略增至每件約人民幣1.73元，主要是由於年內向一名主要客戶銷售的型號組合發生變化，包括向該客戶銷售240,000件平均售價較高的型號(2023財年並無此項銷售)。截至2025年9月30日止九個月，平均售價降至每件約人民幣1.32元，反映策略性降價以提升市場競爭力，與上述方法一致。

IGBT產品的平均售價由2023財年的每件約人民幣9.17元降至2024財年的每件約人民幣1.45元，主要是由於年內向新客戶銷售100,000件某一型號的IGBT產品所致，該型號的平均售價較2023財年售出的IGBT型號為低。截至2025年9月30日止九個月，平均售價增至每件約人民幣3.04元，主要是由於銷售價格較高的IGBT型號所致，其為截至2025年9月30日止九個月銷售的主要型號，性能相比2024財年銷售的主要型號有所提升。

其他產品的平均售價由2022財年的每件約人民幣0.13元微增至2023財年的每件約人民幣0.15元，主要是由於2023財年銷售228件SiC MOSFET及6件GaN MOSFET，兩者的平均售價均高於2022財年售出的該類別其他產品的平均售價。於2024財年，此類產品的平均售價進一步增至每件約人民幣0.27元，主要是由於2023財年未售出平均售價較高的晶圓所致。截至2025年9月30日止九個月，平均售價降至每件約人民幣0.10元，反映策略性降價以提升市場競爭力，與應用於其他產品類別的方法一致。

概 要

毛利及毛利率

下表載列我們於所示年度按產品類型劃分的毛利及毛利率明細。

	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	人民幣千元	毛利率 %	人民幣千元	毛利率 %	人民幣千元	毛利率 %	人民幣千元	毛利率 %	人民幣千元	毛利率 %
MOSFET	93,250	55.8	62,114	55.0	69,149	57.0	46,189	56.7	60,034	57.2
其他	36	32.2	33	36.6	63	26.5	35	58.2	47	21.7
總計	93,286	55.8	62,147	55.0	69,212	56.9	46,224	56.7	60,081	57.1

下表載列往績記錄期間各年度／期間我們產品的毛利及毛利率：

產品類型		截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
產品類別	小類	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
		人民幣千元	毛利率 %	人民幣千元	毛利率 %	人民幣千元	毛利率 %	人民幣千元	毛利率 %	人民幣千元	毛利率 %
	溝槽	33,457	54.6	25,726	54.9	30,670	57.6	21,195	56.9	23,171	58.2
MOSFET	SGT	57,056	56.6	33,288	55.8	34,029	57.1	22,234	56.8	33,323	57.6
	超結	2,737	54.9	3,100	48.6	4,450	51.6	2,760	55.3	3,540	48.6
IGBT		-	-	4	36.7	38	25.5	12	50.3	19	11.6
其他 ⁽¹⁾		36	32.2	29	36.6	25	28.3	23	63.5	28	52.3
總計		93,286	55.8	62,147	55.0	69,212	56.9	46,224	56.7	60,081	57.1

附註1：其他包括SiC MOSFET、GaN MOSFET、晶圓及二極管等。

概 要

我們的毛利由2022財年的約人民幣93.3百萬元減少約33.4%至2023財年的約人民幣62.1百萬元，主要是由於同期收益減少所致，而毛利率微降至約55.0%。2024財年，我們的毛利增長約11.4%至人民幣69.2百萬元，與收益增長一致，毛利率為約56.9%。截至2025年9月30日止九個月，毛利較2024年同期增加約30.0%，由約人民幣46.2百萬元增加至約人民幣60.1百萬元，毛利率由約56.7%增加至約57.1%。有關我們於往績記錄期間的毛利及毛利率波動的原因，請參閱本文件「財務資料 – 各期經營業績的比較」。

下表載列於往績記錄期間，按產品於客戶下游產品的應用情況劃分的產品銷售毛利及毛利率明細：

產品類別	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	毛利 人民幣千元	毛利率 %	毛利 人民幣千元	毛利率 %	毛利 人民幣千元	毛利率 %	毛利 人民幣千元	毛利率 %	毛利 人民幣千元	毛利率 %
消費電子	64,039	57.3	40,378	56.8	41,350	60.6	27,779	60.9	35,324	59.7
工業控制	18,756	53.3	17,146	50.5	21,617	52.8	14,296	51.6	18,055	56.8
汽車電子	8,600	51.0	1,760	58.7	1,725	44.6	968	43.2	3,077	45.3
新能源及儲能	1,871	54.3	2,862	57.7	4,515	52.4	3,176	53.8	3,625	48.7
醫療設備	20	55.4	1	65.1	5	67.8	5	67.5	-	-
總計	93,286	55.8	62,147	55.0	69,212	56.9	46,224	56.7	60,081	57.1

概 要

合併財務狀況表節選項目

	2022年 人民幣千元	於12月31日 2023年 人民幣千元	2024年 人民幣千元	2025年 9月30日 人民幣千元
非流動資產				
物業、廠房及設備	3,262	2,888	2,824	2,379
使用權資產	1,415	1,523	636	3,388
其他無形資產	311	239	197	133
預付款項及按金	226	68	401	169
按公平值計入損益的金融資產	–	–	9,878	9,878
遞延稅項資產	665	574	881	1,120
非流動資產總額	5,879	5,292	14,817	17,067
流動資產				
存貨	32,605	23,900	25,520	39,767
貿易應收款項及應收票據	60,906	37,136	53,811	55,352
預付款項、按金及其他應收款項	1,567	1,301	4,744	9,303
按公平值計入損益的金融資產	10,801	66,092	21,015	9,000
定期存款	–	–	–	1,812
現金及現金等價物	17,980	2,858	16,219	12,676
流動資產總額	123,859	131,287	121,309	127,910
流動負債				
貿易應付款項	13,997	8,897	12,274	16,017
其他應付款項及應計費用	12,376	5,820	8,911	5,151
計息銀行及其他借款	25,790	19,790	11,377	722
租賃負債	801	941	202	795
應付稅項	4,719	1,090	2,624	2,988
流動負債總額	57,663	36,538	35,388	25,673
流動資產淨值	66,196	94,749	85,921	102,237
非流動負債				
計息銀行及其他借款	3,000	–	–	–
租賃負債	664	613	448	2,618
非流動負債總額	3,664	613	448	2,618
資產淨值	68,411	99,428	100,290	116,686

概 要

我們的流動資產淨值由2023年12月31日的約人民幣94.7百萬元減少至2024年12月31日的約人民幣85.9百萬元，主要是由於以下各項的綜合影響：(i)採購及儲備原材料以支持年末銷售增長而導致貿易應付款項增加約人民幣3.4百萬元；(ii)其他應付款項及應計費用增加約人民幣3.1百萬元；及(iii)出售中國的銀行發行的理財產品導致按公平值計入損益的金融資產減少約人民幣45.1百萬元；由以下各項所抵銷：(i)貿易應收款項及應收票據增加約人民幣16.7百萬元，與我們的銷售額增加一致；及(ii)計息銀行及其他借款減少約人民幣8.4百萬元，乃由於償還銀行及其他借款所致。

我們的流動資產淨值由2022年12月31日的約人民幣66.2百萬元增加至2023年12月31日的約人民幣94.7百萬元，主要是由於(i)按公平值計入損益的金融資產增加約人民幣55.3百萬元，主要由於購買中國的銀行發行的理財產品；(ii)貿易應付款項減少約人民幣5.1百萬元，主要由於自供應商的採購減少，與主要由於功率半導體行業於2023年的去庫存週期導致的銷售訂單減少一致；(iii)其他應付款項及應計費用減少約人民幣6.5百萬元，主要是由於(a)應付僱員花紅減少導致應付薪金減少約人民幣2.9百萬元及(b)其他應付稅項減少約人民幣3.2百萬元；及(iv)償還銀行及其他借款導致計息銀行及其他借款減少約人民幣6.0百萬元。

我們的流動資產淨值由2024年12月31日的約人民幣85.9百萬元增至2025年9月30日的約人民幣102.2百萬元，主要是由於(i)存貨增加約人民幣14.2百萬元，主要因在製品存貨增加約人民幣4.2百萬元及製成品增加約人民幣6.8百萬元，乃受業務增長所推動，因此與收益增加一致；(ii)預付款項、按金及其他應收款項增加約人民幣4.6百萬元，主要是由於[編纂]開支預付款項增加所致；(iii)其他應付款項及應計費用減少約人民幣3.8百萬元；及(iv)計息銀行及其他借貸減少約人民幣10.7百萬元，是由於償還於2025年4月到期的其他借貸人民幣10.0百萬元所致。

於2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年9月30日，我們分別錄得資產淨值約人民幣68.4百萬元、人民幣99.4百萬元、人民幣100.3百萬元以及人民幣116.7百萬元。我們的資產淨值由2022年12月31日的約人民幣68.4百萬元增加約45.3%至2023年12月31日的約人民幣99.4百萬元，主要是由於年內錄得溢利約人民幣31.0百萬元。我們的資產淨值由2023年12月31日的約人民幣99.4百萬元增加約0.9%至2024年12月31日的約人民幣100.3百萬元，主要是由於年內錄得溢利約人民幣35.11百萬元，被宣派股息人民幣51.3百萬元所抵銷。我們的資產淨值由2024年12月31日的約人民幣100.3百萬元增加約16.3%至2025年9月30日的約人民幣116.7百萬元，主要是由於期內賺取利潤約人民幣30.3百萬元，被已宣派股息人民幣15.0百萬元所抵銷。

有關進一步詳情，請參閱本文件「財務資料—流動資產／負債淨額」及「附錄一—會計師報告」章節。

概 要

現金流量

下表載列所示年度綜合現金流量表中的節選現金流量資料。本資料應與本文件附錄一會計師報告所載的綜合財務資料一併閱讀。

	截至12月31日止年度			截至9月30日止九個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營運活動所得現金流量淨額	51,133	50,776	23,262	15,750	15,923
投資活動所得／(所用)現金流量淨額	(13,539)	(54,761)	34,681	25,309	10,519
融資活動所用現金流量淨額	(26,707)	(11,137)	(44,582)	(41,901)	(29,985)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	10,887	(15,122)	13,361	(842)	(3,543)
年初現金及現金等價物	7,093	17,980	2,858	2,858	16,219
年末現金及現金等價物	17,980	2,858	16,219	2,016	12,676

概 要

主要財務比率

下表載列我們於所示日期或截至該日止年度的若干主要財務比率。

	截至12月31日止年度／於12月31日			截至2025年 9月30日 止九個月／ 於2025年 9月30日
	2022年	2023年	2024年	
毛利率 ⁽¹⁾	55.8%	55.0%	56.9%	57.1%
純利率 ⁽²⁾	32.0%	27.4%	28.9%	28.8%
股本回報率 ⁽³⁾	78.4%	31.2%	35.0%	34.6%
總資產回報率 ⁽⁴⁾	41.3%	22.7%	25.8%	27.9%
流動比率 ⁽⁵⁾	2.1	3.6	3.4	4.9
速動比率 ⁽⁶⁾	1.6	2.9	2.7	3.4
資產負債比率 ⁽⁷⁾	44.2%	21.5%	12.0%	3.5%
債務權益比率 ⁽⁸⁾	17.9%	18.6%	淨現金狀況	淨現金狀況
利息覆蓋率 ⁽⁹⁾	48.6	30.4	43.7	131.7

附註：

- (1) 毛利率按年內毛利除以年內總收益再乘以100%計算。
- (2) 純利率乃按年內溢利及全面收益總額除以年內總收益再乘以100%計算。
- (3) 股本回報率按年內溢利及全面收益總額除以該年權益總額再乘以100%計算。僅供說明，截至2025年9月30日止九個月的股本回報率按年化基準計算，未必代表截至2025年12月31日止年度的比率，且與2022財年、2023財年及2024財年不可比。
- (4) 總資產回報率按年內溢利及全面收益總額除以該年總資產再乘以100%計算。僅供說明，截至2025年9月30日止九個月的總資產回報率按年化基準計算，未必代表截至2025年12月31日止年度的比率，且與2022財年、2023財年及2024財年不可比。
- (5) 流動比率按流動資產除以流動負債計算。
- (6) 速動比率按流動資產減存貨除以流動負債計算。
- (7) 資產負債比率乃根據我們於各日期的債務(即我們的計息銀行及其他借款和租賃負債)除以權益總額再乘以100%計算。
- (8) 債務權益比率根據我們於相關日期的淨負債(即我們的計息銀行及其他借款和租賃負債，扣除現金及現金等價物)除以我們的總權益再乘以100%計算。
- (9) 利息覆蓋率以扣除利息及稅項前溢利除以融資成本計算。

概 要

我們的控股股東

緊接[編纂]前，劉先生與吳女士(劉先生的配偶)合計擁有我們已發行股本總額約95.0%的權益，包括(i)劉先生直接持有約52.40%的權益，(ii)劉先生以唯一普通合夥人身份控制以下各項權益而間接控制的合計約23.00%的權益：(1)尚晶一號15.00%權益、(2)宇拓志承投資5.00%權益、(3)尚晶二號2.00%的權益及(4)尚晶三號1.00%的權益；及(iii)間接持有的尚晶投資(吳女士為其唯一普通合夥人)的約19.60%的權益。因此，根據上市規則的涵義，[編纂]後，劉先生、吳女士、尚晶一號、宇拓志承投資、尚晶二號、尚晶三號及尚晶投資構成本公司的控股股東組，合共持有本公司於最後實際可行日期已發行股本約95.0%的權益。

緊隨[編纂]完成後，並假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並未發生其他變化，我們的控股股東將合共持有本公司已發行股本的約[編纂]%。

股息

本公司分別於2022財年及2024財年以及截至2025年9月30日止九個月向股東宣派及結算股息約人民幣32.5百萬元、人民幣51.3百萬元及人民幣15.0百萬元。

概不保證將於任何年度宣派或分派任何金額的股息。儘管我們目前並無正式股息政策或固定股息分派率，但董事會日後或會於考慮多項因素後宣派股息，包括我們的未來盈利及現金流入、未來資金使用計劃、我們業務的長期發展、法定儲備、任意公積金、法律及監管限制以及董事認為相關的其他因素。分派任何中期股息或建議任何末期股息的決定須經董事會批准，並將由董事會酌情決定。此外，任何財政年度的末期股息將須經股東批准。我們的董事會目前並無制定股息政策的計劃。再者，我們的股息政策亦須遵守我們的組織章程細則、中國公司法及任何其他適用中國法律及法規。

根據中國法律，股息僅可從可分派溢利派付。可分派溢利為我們根據中國財政部頒佈的企業會計準則釐定的純利，減去任何累計虧損的收回以及我們須作出的法定及其他儲備的撥款。

概 要

[編纂]統計數據

下表統計數據基於假設(i)[編纂]已完成，根據[編纂]已發行[編纂]股[編纂]；及(ii)[編纂]未獲行使。

	基於最低[編纂] 每股[編纂] [編纂]港元	基於最高[編纂] 每股[編纂] [編纂]港元
股份[編纂] ⁽¹⁾	[編纂]百萬港元	[編纂]百萬港元
未經審核[編纂]經調整每股綜合有形資產淨值 ⁽²⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) [編纂]乃基於緊隨[編纂]完成後預計將發行的[編纂]股股份計算(假設[編纂]未獲行使)。
- (2) 未經審核[編纂]經調整每股綜合有形資產淨值乃經作出本文件附錄二A「未經審核[編纂]財務資料」一節所述調整後，基於緊隨[編纂]完成後已發行合計[編纂]股股份計算。除本文件所披露者外，概無作出調整以反映本集團於2025年9月30日之後的任何交易結果或所訂立的其他交易。

[編纂]用途

假設(i)[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元(即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數)並(ii)[編纂]未獲行使，我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的估計[編纂]及其他估計[編纂]開支後，我們從[編纂]中收取的[編纂]將約為[編纂]百萬港元。

我們擬將[編纂][編纂]用於以下各項：

- [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)預期將用於增強晶體管產品的研發及產業化能力。具體而言：
 - (i) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)預期將用作研發開支，以開發我們的MOSFET、IGBT以及SiC MOSFET與GaN MOSFET產品。
 - (ii) 預期[編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於擴充辦公室及實驗室空間。
 - (iii) 預期[編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於購置新研發基礎設施及設備。

概 要

- (iv) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)預期將用於支付研發及技術產品部門的薪金開支，我們計劃於未來幾年穩步擴充該等團隊。
- [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)預期將用於擴大我們在海內外的產品銷售及營銷能力。具體而言：
 - (i) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)預期將用於發展新的及培育現有客戶及供應商關係，以及在中國及海外(即東南亞及南亞市場)宣傳及推廣我們的品牌及產品線。
 - (ii) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)預期將用於支付我們銷售及營銷部門人員的薪金開支，我們計劃於未來幾年擴充該團隊人員，以支持我們的擴充計劃。
 - (iii) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)預期將用作租用場地及為我們的產品設立展廳，以及租用會議室及商務接待區以與客戶及供應商進行業務及商務談判的開支。
- [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)預期將用作營運資金及一般公司用途。

截至2025年12月31日止年度之[編纂]

[編纂]

概 要

[編纂]開支

假設[編纂]未獲行使，按[編纂]範圍的中間價每股[編纂]港元計算，[編纂]的估計[編纂]開支總額為人民幣[編纂]元(相當於約[編纂]港元)。我們的[編纂]開支總額包括(i)[編纂]相關開支人民幣[編纂]元(相當於約[編纂]港元)；及(ii)非[編纂]相關開支人民幣[編纂]元(相當於約[編纂]港元)。於往績記錄期間，我們產生[編纂]開支人民幣[編纂]元，其中人民幣[編纂]元及人民幣[編纂]元於2024財年及截至2025年9月30日止九個月的損益表中確認，人民幣[編纂]元及人民幣[編纂]元於截至2024年12月31日及2025年9月30日財務狀況表中確認為預付款項，將於[編纂]後入賬列作權益扣減。

於往績記錄期間後，我們預期於[編纂]前及完成後將產生[編纂]開支人民幣[編纂]元(相當於約[編纂]港元)，其中人民幣[編纂]元(相當於約[編纂]港元)預期將於我們的損益表中確認為開支，人民幣[編纂]元(相當於約[編纂]港元)預期將於[編纂]後入賬列作權益扣減。於往績記錄期間後將產生的[編纂]開支包括(i)[編纂]相關開支人民幣[編纂]元(相當於約[編纂]港元)，及(ii)非[編纂]相關開支人民幣[編纂]元(相當於約[編纂]港元)。

上述[編纂]開支為最新實際可行的估計，僅供參考，實際金額可能與此估計有異。

COVID-19疫情的影響

於2022年，COVID-19疫情再度爆發，包括高傳染性德爾塔及奧密克戎變種在中國乃至全球廣泛傳播，對經濟狀況及社會穩定造成不利影響。儘管中國政府因疫情再度爆發而重新實施疫情隔離措施及限制性政策，但該等措施對本公司營運的影響甚微，是因為向供應商發出的訂單未受影響，且我們能夠於該期間正常向客戶交付訂單。

概 要

於往績記錄期間，我們的財務表現受到輕微影響，是由於疫情導致全球芯片短缺，加上2022年疫情後半導體器件需求增加，2022年至2023年需求發生重大轉變，引發去庫存週期，從而引致2023財年半導體行業的價格及需求均下降。根據益普索的資料，疫情後，中國對半導體產品的需求於2020年為1,510億美元，2021年增至1,880億美元，並持續增長至2022年末左右，此趨勢反映在人工智能、HPC、5G、新能源汽車及工業應用的需求激增，導致全球晶片短缺，進而推升2022年中國市場上MOSFET及IGBT的8英寸晶圓的平均價格大幅上漲。然而，2022年末產能增加及市場需求減弱導致庫存過剩，致使令價格於2024年下降。未來五年，中國8英寸硅晶圓的價格預計會保持相對穩定。根據益普索的資料，8英寸晶圓是MOSFET的主要原材料，由於晶圓價格直接影響MOSFET的生產成本，進而影響其銷售價格，其價格對2019年至2024年中國MOSFET的最終產品價格有直接且顯著的影響。2020年至2022年晶圓價格上漲促使MOSFET平均價格上升，而2022年至2024年晶圓價格下跌則促使MOSFET平均價格降低。然而，MOSFET價格變化的幅度往往超過晶圓價格變化的幅度，這表明其他因素(如需求、供應鏈動態和生產成本)於決定最終MOSFET價格方面也發揮了關鍵作用。未來五年，中國MOSFET價格預計將趨於穩定或略有下降。隨著生產技術的成熟，規模經濟可能會導致價格下降。與市場趨勢相符，本公司MOSFET產品之平均售價於往績記錄期間呈現下降趨勢，詳情請參閱「業務－產品組合－產品定價」一節。然而，來自汽車電子(尤其是電動汽車)、5G電信及可再生能源應用等高增長行業的強勁需求可能會維持MOSFET的需求。該持續需求可能會為價格提供一定支撐，部分抵銷供應增加和競爭加劇帶來的下降趨勢。

儘管對我們2023財年的收益有輕微影響，但董事認為，COVID-19對我們財務表現的影響只是暫時的，並無造成長期不利影響，是因為2024財年我們銷售的產品總數及收益均有所增加。

近期發展及無重大不利變動

於往績記錄期間之後及直至最後實際可行日期，我們的業務運營、收益及成本架構保持穩定。

截至最後實際可行日期，憑藉銷售代表的業務發展努力，本集團已分別於與印度及越南的多名新客戶建立業務關係方面取得進展，並正在開發定製解決方案及原型，以與其下游產品進行測試，主要應用領域為新能源及儲能以及消費電子等。

董事確認，自2025年9月30日(即最近期經審核財務報表日期)起直至本文件日期；我們的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動，且自2025年9月30日起概無發生對本文件附錄一會計師報告所載資料構成重大不利影響的事件。